



## **Processus Ultimes d'épitaxie de Semiconducteurs**

**Colloque Annuel, Amphi Guyon, 29 Av. schuman, Aix-en-Provence, 3-5 juillet 2013**

### **Présentations invitées**

**Nicolas Combe** (CEMES, Toulouse)

Auto-organisation à l'échelle atomique induite par une onde acoustique stationnaire

**Jean-Noel Aqua** (INSP, Paris)

Auto-organisation de boîtes quantiques sur un pattern : une instabilité contrainte

**Maxime Ignacio** (ILM, Lyon)

Solid state wetting on nano-pillar arrays : dynamics and elasticity effects

**Frank Glas** (LPN, Macroussis)

Modeling and quantitative analysis of self-catalyzed GaAs nanowire growth

**Christophe Bichara** (CINAM, Marseille)

Etude par simulation numérique de la croissance catalytique de nanotubes de carbone et de graphène

**Pierre Müller** (CINAM, Marseille)

Démouillage à l'état solide: résultats récents

**Joël Eymery** (INAC CEA)

Mécanismes de croissances de nanofils et de leurs hétérostructures: un enjeu pour des composants opérationnels

**Jesus Zuniga-Perez** (CRHEA)

Croissance MOVPE de micro/nanostructures GaN sur substrats patternés"

**Pierre Ruterana** (CIMAP, Caen)

TEM haute résolution et ses variantes

**Etienne Talbot** (GPM, Rouen)

Sonde atomique

**Yves Garreau** (LMPQ, Paris)

Analyse par rayons X au synchrotron

**Yvon Cordier** (CRHEA, Sophia-Antipolis)

Mesures in-situ et ex-situ des déformations dans les films GaN/AlN épitaxiés

**Y. André** (Inst. Pascal)

HVPE et le contrôle des facettes développées

**Marco Faustini** (Laboratoire chimie Matière Condensée, Université Paris 6)  
Couches inorganiques nanostructurées préparées par auto assemblage: une nouvelle plateforme multifonctionnelle

**Jacques Gierak** (LPN)  
Une expertise du LPN : Les faisceaux d'ions focalisés ultimes et leurs applications

**Bruno Gérard**  
GaAs sur Si

**Romain Bachelet** (INL)  
Intégration d'oxydes fonctionnels sur semiconducteurs

**Yann Genuist** (CNRS - Grenoble)  
Dopage p des arséniures: cas de la cellule carbone à chauffage par bombardement électronique

**Yoann Cure** (CEA - Grenoble)  
AnaRHEED: Logiciel d'analyse du RHEED suivi en temps réel du paramètre de maille

**Philippe Regreny** (INL - Lyon)  
Développement de l'épitaxie par jets moléculaires pour la croissance d'oxydes pérovskites sur silicium

---

# Processus Ultimes d'épitaxie de Semiconducteurs

Colloque Annuel, Amphi Guyon, 29 Av. schuman, Aix-en-Provence, 3-5 juillet 2013

## Programme du 03/07/2013

12h30 : *Buffet repas*

14h00-14h15 : Présentation du GDR

14h15-17h15 : Présentations invitées - Thématiques N°5, N°6 et N°7

- Thématique 5. Nanostructuration des substrats
- Thématique 6. Auto-organisation et Epitaxie sur substrat fonctionnalisé
- Thématique 7. Croissance sélective et épitaxie latérale

17h15-17h45 : *Pause café*

17h45-19h30 : Table ronde sur les thématiques N°5, N°6 et N°7  
Animateurs N. Gogneau, A. Ronda, E. Gil

## 04/07/2013

9h00-11h30 : Présentations invitées - Thématiques N°1 et N°3  
- Thématique 1. Nouveaux concepts en germination, croissance  
- Thématique 3. Couplage entre théorie et expérience

11h30-12h00 : *Pause café*

12h00-13h00 : Table ronde sur les thématiques N°1 et N°3  
Animateurs O. Pierre-Louis, P. Muller

13h00-14h30 : *Lunch*

14h30- 15h30: Présentations courtes des posters

15h30-16h30: Présentations invitées – Thématique N°10

- Thématique 10. Développements instrumentaux

16h30-17h00: Table ronde sur la thématique N°10  
Animateur A. Arnoult

17h00-20h00 : *Session Posters + Café*

20h00 : *Dîner du GDR*



## Processus Ultimes d'épitaxie de Semiconducteurs

Colloque Annuel, Amphi Guyon, 29 Av. schuman, Aix-en-Provence, 3-5 juillet 2013

### Programme du 05/07/2013

9h00-11h30: Présentations invitées - Thématiques N°2 et N°9

- Thématique 2. Hétéroépitaxie sur silicium
- Thématique 9. Intégration monolithique hétérogène

11h30-12h00 : *Pause café*

12h00-13h00: Table ronde sur les thématiques N°2 et N°9  
Animateurs F. Semon, Y. Cordier, G. Saint Girons

13h00-14h00: *Lunch*

14h00- 16h30 : Présentations invitées - Thématiques N°4 et N°8

- Thématique 4. Couplage composition, contrainte et morphologie en hétéro-épitaxie de semiconducteurs
- Thématique 8. Nouvelles approches de caractérisation locale

16h30- 17h30: Table ronde sur les thématiques N°4 et N°8  
Animateurs X. Wallart, P. Atkinson

17h30 : *Conclusions de la réunion plénière*